

半導体 シリーズ

- ・コア部品自社開発、カスタマイズ可

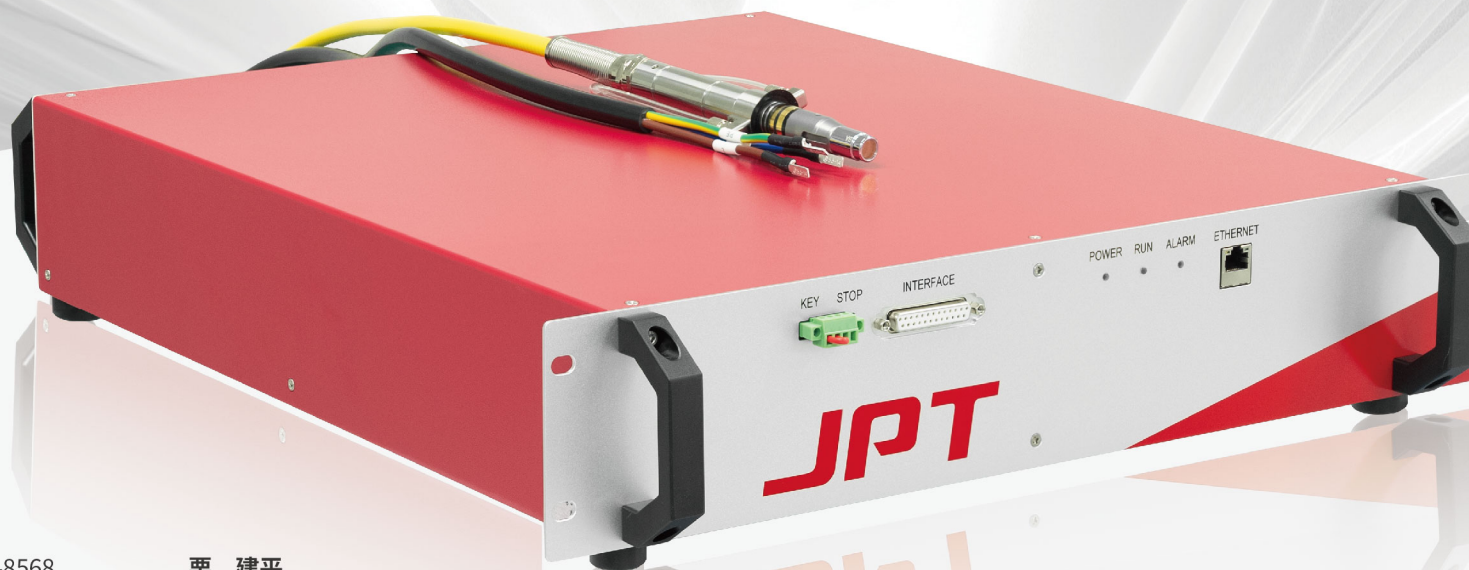
レーザー溶接

レーザー焼入れ

レーザー加熱

その他

- ▶ 光電変換率が高く、より省エネ実現
- ▶ ファイバケーブル長さとかア径カスタマイズ可
- ▶ 小型化設計
- ▶ メンテナンスフリー運転



長崎敏幸

電話: 045-534-8568

Eメール: nagasaki@jptjp.jp

栗 建平

Eメール: albert.li@jptoe.com

半導体 シリーズ 仕様

連続光ファイバーレーザー

内容	単位	パラメータ	
平均出力パワー	W	2000	3000
ビームパラメータ積	mm×mrad	≤40@600μm	
波長	nm	976±10	
スペクトル幅 @3dB	nm	<6	
ケーブル長さ	M	10	
冷却方式	/	水冷	
動作電圧	V	220±10%	
最大消費電力	W	4600	7000
光On/Off時間	μs	20	
最大変調周波数	kHz	20	
動作温度範囲	°C	10~40	
貯蔵温度範囲	°C	-10~60	
重量	kg	27	31
寸法 (ハンドル含まない)	mm	505×482×105	
寸法 (ハンドル含み)	mm	575×482×105	